

Транзисторы КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г



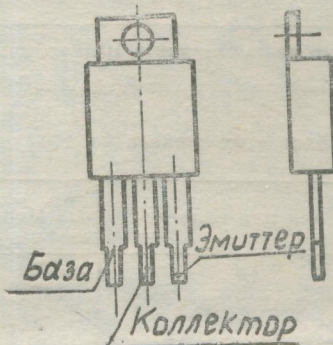
Э Т И К Е Т К А



Кремниевые меза-планарные составные п-р-п мощные транзисторы КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г в пластмассовом корпусе предназначены для работы в усилителях низкой частоты, ключевых схемах.

Вид климатического исполнения УХЛ 3.1, 5.1.

Корпус типа КТ-28-2 по ГОСТ 18472-88



Масса транзистора не более 3 г

Таблица 1

Основные электрические параметры при $T_{корп.} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначен.	Норма	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока $U_{кэ} = 3\text{ В}$, $I_{к} = 3\text{ А}$	$h_{21э}$	750	—
Обратный ток коллектора, мА $U_{кб} = 100\text{ В}$ для КТ829А $U_{кб} = 80\text{ В}$ для КТ829Б $U_{кб} = 60\text{ В}$ для КТ829В $U_{кб} = 45\text{ В}$ для КТ829Г	$I_{кбо}$	—	0,2
		—	0,2
		—	0,2
		—	0,2
Обратный ток эмиттера, мА $U_{эб} = 5\text{ В}$, $I_{к} = 0$	$I_{эбо}$	—	2,0
Граничное напряжение, В для КТ829А $L = 40\text{ мГн}$ для КТ829Б для КТ829В $I_{к} = 0,1\text{ А}$ для КТ829Г		100	—
		80	—
		60	—
		45	—
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В $I_{к} = 3\text{ А}$ $I_{б} = 0,012\text{ А}$	$U_{кэ\text{ нас}}$	—	2

Напряжение насыщения база-эмиттер, В I _к =3 А I _б =0,012 А	U _{бэ} нас	—	2,5
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте U _{кэ} =3 В, I _к =3 А f=10 МГц	(h _{21э})	0,4	—
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА U _{кэ} =50 В для КТ829А U _{кэ} =40 В для КТ829Б U _{кэ} =30 В для КТ829В U _{кэ} =22 В для КТ829Г	I _{кэ0}	— — — —	0,5 0,5 0,5 0,5

Содержание драгметаллов в 1000 транзисторов:

Золота — 0,3347 г

Серебра —

Содержание цветных металлов и их сплавов в 1000 шт. транзисторов

Наименование цветного металла или сплава	Марка	Масса, г
Медь	МО6	1820

Сведения о приемке

ОТК ВЗВ

Штамп ОТК

Указания по эксплуатации

Указания по применению и эксплуатации транзисторов по ГОСТ 11630-84, ОСТ II 336.907.0-79.

Транзисторы необходимо применять с теплоотводами. Крепление транзисторов к теплоотводам должно обеспечивать надежный тепловой контакт. Для улучшения теплового контакта необходимо наносить на нижнее основание корпуса транзистора жидкость ПМС-100 по ГОСТ 13032-77 или другую теплопроводящую смазку.

При пайке выводов температура корпуса транзистора не должна превышать 85°C.

Допускается формовка выводов транзисторов в направлении, перпендикулярном плоскости его основания. Минимально допустимое расстояние от корпуса до места изгиба 3 мм.

Формовку проводить с обязательной фиксацией выводов. Место фиксации — между корпусом и местом изгиба.